

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| (51) Int. Cl. <sup>5</sup><br>H01L 23/538 | (11) 공개번호<br>(43) 공개일자                   | 특 1991-0017611<br>1991년 11월 05일 |
| (21) 출원번호                                 | 특 1990-0002996                           |                                 |
| (22) 출원일자                                 | 1990년 03월 07일                            |                                 |
| (71) 출원인                                  | 금성일렉트론 주식회사     문정환<br>충청북도 청주시 향정동 50번지 |                                 |
| (72) 발명자                                  | 전영권                                      |                                 |
| (74) 대리인                                  | 서울시 송파구 가락동 192 극동아파트 2-104<br>김용인, 심창섭  |                                 |

**심사청구 : 있음**

**(54) 메탈 리큐드의 홀 필링을 이용한 집적회로의 배선 형성방법**

**요약**

내용 없음

**대표도**

**도2**

**명세서**

[발명의 명칭]

메탈 리큐드의 홀 필링을 이용한 집적회로의 배선 형성방법

[도면의 간단한 설명]

제 2도는 본 발명의 배선층 형성방법, 제 3도는 제 2도를 설명하기 위한 그래프.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

실리콘 혹은 1차 배선층(1)위에 콘택트 및 비어 피일드 산화막(2)이 형성된 것에 있어서, A1 이나 A1 합금(3)의 저저항 금속층을 하부 배선층으로 증착하고 상부 배선층으로서 열처리 혹은 급속 열처리 온도에서 하부 배선층의 금속재료와 상평형을 이루는 액상조성의 A1합금(4)을 증착하며, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>(5)를 상부물질로 디포지션하고 열처리 혹은 급속 열처리하여 상부 배선층을 액상으로 만들어 하부배선층 사이로 흘러들어가게 한 후 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>(5)를 제함을 특징으로 하는 메탈 리큐드의 홀 필링을 이용한 집적회로의 배선 형성방법.

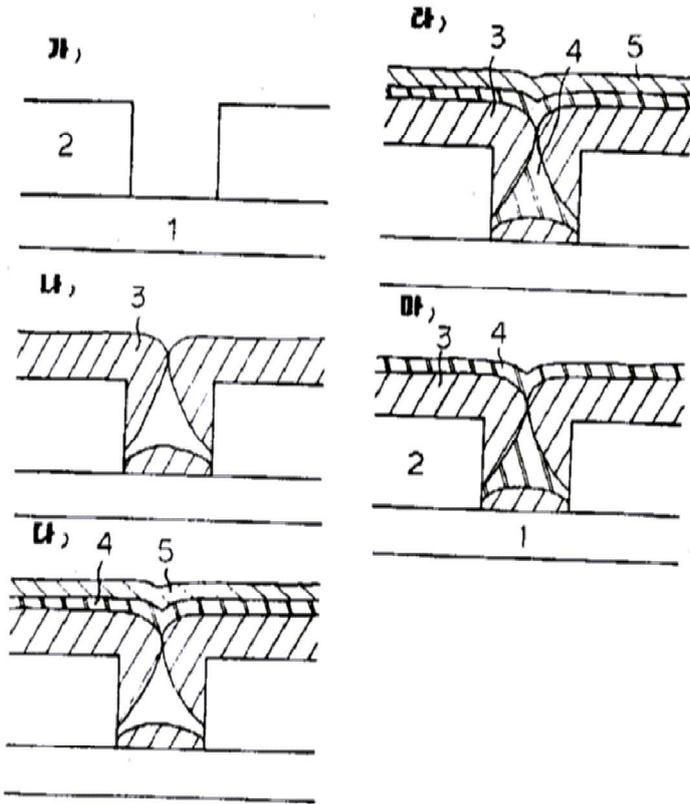
**청구항 2**

제 1항에 있어서, 하부 배선층과 상부 배선층의 합금조성을 각각 다르게 하여 열처리 온도에서 액상을 형성시킴을 특징으로 하는 메탈 리큐드의 홀 필링을 이용한 집적회로의 배선 형성방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면2



도면3

